



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14119—93

---

## 半导体集成电路双极熔丝式 可编程只读存储器 空白详细规范

Blank detail specification for semiconductor integrated circuit  
fusible-link programmable bipolar read-only memories

(可供认证用)

1993-03-18 发布

1993-08-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

## 半导体集成电路双极熔丝式可 编程只读存储器 空白详细规范

GB/T 14119—93

Blank detail specification for semiconductor integrated circuit  
fusible-link programmable bipolar read-only memories

(可供认证用)

本规范规定了编制半导体集成电路双极熔丝式可编程只读存储器(以下简称器件)详细规范的基本原则。

本规范是半导体集成电路一系列空白详细规范中的一个,它应与 GB 4589.1《半导体器件 分立器件和集成电路总规范》和 GB 12750《半导体集成电路分规范(不包括混合电路)》一起使用。

要求的资料

空白详细规范首页[1]~[9]各栏应填写与下列各项相对应的内容。

详细规范的识别

- [1] 发布详细规范的国家标准化机构名称。
- [2] 详细规范的 IECQ 编号。
- [3] 总规范和分规范编号及版本号。
- [4] 详细规范的国家编号,发布日期及国家标准体系需要的资料。

器件的识别

- [5] 主要的功能和型号。
- [6] 典型结构(材料、主要工艺)和封装。

如果器件有多种派生产品,应当给出相互之间的差别。例如,以对照表的形式列出各自性能的特点。

详细规范应给出包括下述内容的简要说明:

- 工艺(TTL、ECL 等);
- 结构(字×位);
- 输出电路的类型(例如 三态……);
- 主要功能。

[7] 外形图、引出端识别、标志和(或)外形有关的参考文件。

[8] 质量评定类别(按 GB 4589.1 第 2.6 条)。

[9] 参考数据。

[本规范中,方括号所列内容仅供指导编写详细规范使用,不必在详细规范中列出。]

[本规范中,电特性或额定值表格中的“×”表示在详细规范中必须填写的值;“—”表示无内容可写。]